

GB/T 2900.66-2004

GB/T 2900.66-2004

IEC 60050-521 2002

IEC 60050-521 2002

GB/T 2900

66

521

GB/T 2900

前 言

GB/T 2900 的本部分等同采用 IEC 60050-521:2002《国际电工词汇 第 521 部分:半导体器件和集成电路》。

本部分等同翻译 IEC 60050-521:2002。

为了便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

“本国际标准”一词改为“本部分”;

删除国际标准的前言和说明。

本标准中术语编号与 IEC 60050-808:2002 保持一致。

本标准由全国电工术语标准化技术委员会提出。

本标准由全国电工术语标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所(CESI)、机械科学研究院。

本标准主要起草人:赵英、顾振球、杨英、罗发明、刘春勋、陈裕焜。

W		Zener voltage 521-05-10
wafer		zero
wafer	521-05-29	residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe) 521-09-14
write		residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device) 521-09-15
dynamic (read/write) memory	521-11-10	zone
read/write memory	521-11-07	growing by zone melting (of a single crystal) 521-03-02
static (read/write) memory	521-11-09	impurity concentration transition zone ... 521-02-67
Z		zone levelling 521-03-04
Zener		zone refining 521-03-03
Zener breakdown (of a PN junction) ...	521-05-09	